EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59108119

PUBLICATION DATE

22-06-84

APPLICATION DATE

13-12-82

APPLICATION NUMBER

57216834

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR:

MATSUMOTO MASAKAZU;

INT.CL.

G05D 23/19 H01L 21/205 H01L 21/31

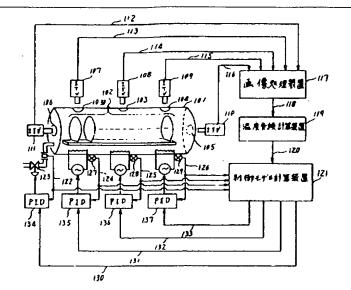
H01L 21/66

TITLE

ON-LINE MEASURING AND

CONTROLLING SYSTEM OF FURNACE

TEMPERATURE



ABSTRACT :

PURPOSE: To make the internal temperature of an object to be heated in a furnace close to an objective temperature by estimating the furnace temperature from picture information obtained from ITVs and inputting the estimated value to a control model.

CONSTITUTION: The ITVs 107~111 are fitted to windows 1030, 103~106 of the furnace 101. The ITVs 107~111 sends the distribution data 112~116 of the furnace temperature to a picture processor 117, which estimates the external temperature of the object in the furnace and applies the estimated temperature information 118 to a temperature conversion calculating device 119. The device 119 applies the estimated temperature information 118 to a control model computer 121 as the temperature input information 120 necessary for a control model. The control model computer 121 calculates the temperature inside the object to be heated by using the temperature distribution estimating model of the object 102 to be heated and controls the flow rate of feeding gas, the heating temperature of a heater, etc. by a closed loop. Consequently, the dispersion of products can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59-108119

(i) Int. Cl.³
 (i) G 05 D 23/19
 (i) H 01 L 21/205
 (i) 21/31
 (i) 21/66

識別記号 庁内整理番号 2117--5H 7739--5F 7739--5F 6851--5F

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

❷炉内温度オンライン計測・制御方式

②特

願 昭57-216834

@出

图57(1982)12月13日

⑫発 明 者 松本邦顕

川崎市麻生区王禅寺1099番地株 式会社日立製作所システム開発 研究所内

⑫発 明 者 松葉育雄

川崎市麻生区王禅寺1099番地株

式会社日立製作所システム開発 研究所内

砂公開 昭和59年(1984)6月22日

⑫発 明 者 松本雅一

下松市東豊井794番地株式会社 日立製作所笠戸工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

砂代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 報

発明の名称 炉内晶度オンライン計測・制御方 式

特許精求の範囲

- 1. 加熱炉内における被加熱物の内部温度の目標 退値制御方式において、加熱炉ののぞき窓にに設 酸された強像手段で得られた熱スペクトル情報 にもとづき被加熱物の外部温度を推定し、 該推 定された外部温度と、炉壁に設置された温度 大型により側定された炉壁温度およびかまでは、 ・機情報等を用いて、 被加熱物の内部 品度 死 能 し、 該推定値と、 予め与えられている被加熱物 の目標温度との形にもとづき、 目標温度 他 の目標温度との形にもとづき、 目標温度 他 ではるように、 ヒータヤガス焼入 は等の制御 段 にを決定することを特徴とする炉内 温度 オン オン 別側方式。
- 2 加熱炉内における被加熱物の内部温度の目標 退値制御方式において、診加熱炉の炉壁を炉棚 方向にゾーン分削し、該炉簾の温度より上記被 加熱物の炉軸方向温度分布を推定する非磁化モ

デル方程式及び、該推定値と目標値との差を評価 する評価関数にもとづき、 該評価関数が最小に なるように炉質温度を決定することを特徴とす る炉内偏度オンライン計測・制御方式。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は半導体の酸化・拡散炉およびCVD炉、 鉄鋼の高炉、ガラスの溶解炉、紙の蒸解釜、化学 関連の反応炉等の制御方式に関し、特に炉内にお かれた被加熱物の内部温度分布のオンライン計削 方法および炉の制御方式に関する。

〔従来技術〕

従来、炉内の温度分布を制御するために

- (1) 外壁温度予測による制御
- (前) 高炉等の目視による制御

などの方法がおこなわれていた。

(川は伊外壁の低度を実側し、この実測値にもとづき炉内の温度分布を予測しては所望の制御をお となり方法であり、(川は高炉内を目視し火炎の色などから炉内の温度分布を予測しては所望の制御

特開明59-108119 (2)

7

をおこなり方法であるが、いずれも過去の経験などにもとづく勘とノワハウに頼るため精緻な炉制 御が不可能であつた。

例えば、拡散炉内のウェハを設計で定められた 温度でウエハ全体を均一に拡散するための拡散炉 の温度制御をおとなり場合に、従来の拡散炉は、 炉壁面全体が一定温度になるように制御されてい たが、ウエハ目体の温度測定法が無いためウエハ **艦度がほとんど分つていなかつた。ウエハ付近に** 虚度センサを装備すると注入されるガスが乱旒状 態となり、ウエハ健康の均一性を損り事になるた め、センサによる炉心部での温度測定を避けなけ ればならない。とのような理由から炉蟹温度より 炉内部のウエハ温度を推定することのできるモデ ルの開発が要求される。従来のように拡散炉の炉 襞を一定温度に加熱する方法によると、ウエハの 位置により協度が異なり最終的に完成した半導体 特性のはらつきを生じ、歩留りを減少させる結果 となる欠点を持つ。

〔発明の目的〕

101の適当な場所に怒1030,103~106 (窓の個数および形状は、炉の大きさや制御方式 によつて異なる)を設け、この窓の位置にITV (工業テレビ)107~111を設備する。 この ITVにより、炉内の温度分布情報112~116 を画像処理装置117に送る。との画像処理装置 117には、超高速パイプラインプロセツサ等に よる高速資準機能や、大容量のリフレツシュメモ り機能を有し、高度な画像処理をリアルタイムで 処理できる機能を具備している。この装置117 により、炉内の被対象物の外部温度(但し、ITV から見える範囲の空間)をその熱スペクトル解析 により推定し、その協度推定情報118を協度変 終計算装置119亿入力する。とこで、各JTV からの協度推定情報を、制御モデル化必要を入力 情報(たとえば、各ITVの温度分布情報を平均 化し平均化温度/ITV)とする。この温度入力 情報120を制御モデル計算装置121亿入力す る。ととでは、被加熱物(ウエハ102)温度分 布推定モデルを用い、入力した温度入力情報120 本発明の目的は、炉内の被加熱物の内部處度分布を、目標處度分布に近づけて運転できるように するための、炉内温度分布のオンライン計測方法 および炉を精緻に制御する方式を提供することに ある。

〔発明の概要〕

炉内温度は高温(たとえば、1000で)のため、耐久性等の問題から通常のセンサ(たとえば熱電対等)を炉内のオンライン計側に利用することはできない。そこで、本発明では炉の適当な位置に窓(現状でも設置されているようなのぞき窓のようなもの)を設け、そこにITV(工業テレビ)を複数台設置し、このITVからの画像情報をもとに、画像処理装備を用いて炉内の温度を推定し、この推定値を制御モデルに入力することにより、炉内の扱加熱物の内部温度を目標温度に近づけて運転する点に特敵がある。

(発明の実施例)

第1図は本発明による半導体の酸化・拡散炉の 第1の実施例の構成を示す。第1図において、炉

を境界値(実測値)として、炉内全ゥエハ102のウエハ面内協度分布を計算により求める。計算法はウエハ温度、ガス温度、およびガス流速に対する熱硫体方程式をモデル化し、温度入力情報120を境界値とし、また、その時の硫入ガス流量122をガス流量計123から、炉機温度124~126を温度計127~129から計測し、これらのデータに基づいて、各ウエハ面内の協度分布を推定計算する。このとき、下記の評価式

J — ⊿ J < J < J + ⊿ J ······· (2) ここで、 ⊿ J : 評価許容幅

特開昭59-108119 (3)

の評価内に入つているかどうか判定する。もし、入つていれば、現状の制御を継続する。もし、入つていなければ、(I)式のJを最小にするように最適計算を行ない、ガス制御目標値130、ヒータ加熱目標値131~133を求める。これらの目標値はPID制御装置として公知のフィードバック制御装置134~137に入力され、炉がオンライン制御される。

つぎに、本発明による第2の実施例にもとづき、 加熱炉内の傷度が側定不可能なとき、炉壁温度を 一定にするだけでは被加熱物が不均一に加熱され るという欠点を改善するために、炉内部状態を推 定するモデルに基づき、加熱炉壁の傷度を例えば 炉膜に装備されたヒータで調整する事により被加 熱物を均一温度で加熱するように制御する手順に ついて詳細に説明する。

第2図は本発明による拡散炉の第2の実施例の 構成と、その温度制御装置との接続関係の一例を 示す。第2図において、対象とする拡散炉101 は円筒型のチューブでウエハ102はその中央部

次に、炉製温度を設定する手軽について税明する。 i 番目のウェハ温度をTi, i 番目の両隣りのウェハ温度をTi(j = i ± 1)、炉壁温度をTF,シリコンの熱伝導率をKw,吸収率をa,ウェハ間の形態係数をG。,ウェハと炉壁との形態係数をF。とするとi 番目のウェハ温度Tiは次の熱方程式を解く事により得られる。

のポート 2020 に乗せられて炉1 0 1 内へ搬送さ れ拡散され再び炉201外へ出て行く。問題とな るのは拡散中の炉軸(2軸)方向の炉内の温度分 布の推定である。ポート中央部にあるウェハは両 隣りのウェハからの直接輻射及び炉騰からの直接 観射により加熱されるので中央部のウェハは両端 部のウエハより高温になるものと推定される。従 つてウェハを均一温度で拡散するための拡散炉の 温度制御は以下のようにして行なわれる。まず初 期入力として、たとえば、ウエハの設計(目原) 温度T を破適計算装置206に入力し、後述す る計算方法によりウェハをヒータ203、204 および205で均一加熱するよう友対称3ゾーン の炉皪温度を決定する。炉蠻温度が決定されると、 センサ208の炉蟹温度測定結果と上記最適計算 装置 6 で決定された炉筬温度との差分を減算器 200で計算してこの差分に基づき、 PIDコン トローラ207を用いる事により、電源209を 調整し、顔記ヒータ203。204をよび205 により所定の温度に加熱する。

ほど変化しないとしてT」(r', t)をT」(r, t)で置き換えて積分配号の外に出す。 G。(r, r')は r = r', の時に最大値を取るような関数であり、それ以外の r', に対しては | r - r', lの4乗に逆比例して小さくなるのでこの近似が可能となる。このような近似に対して(1)式は次のように書く事ができる。

$$\frac{\partial \mathbf{T}_{1}}{\partial t} = -2\mathbf{T}_{1}^{4} + \mathbf{a} \left(\mathbf{T}_{-1}^{4} + \mathbf{T}_{1}^{4}, \mathbf{1}\right) \mathbf{g} \left(\mathbf{r}\right)$$

$$+ \mathbf{a} \mathbf{T}_{F}^{4} f \left(\mathbf{r}\right) + \mathbf{K}_{W} \left(\mathbf{T}_{1}\right) \mathbf{V}_{F}^{2} \mathbf{T}_{1} \dots (2)$$

$$\mathbf{C} \mathbf{C} \mathbf{V}_{F}^{2} = \frac{\partial^{2}}{\partial \mathbf{r}^{2}} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}}$$

(2)式を両端のウェハ、中間部のウェハに分けて 扱わすと次のようになる。

$$\frac{\partial T_{i}}{\partial t} = -2T_{i}^{4} + aT_{i}^{4} + K_{i} (T_{i}) V_{i}^{2} T_{i}$$

$$\frac{\partial T_{i}}{\partial t} = -2T_{i}^{4} + a (T_{i-1}^{4} + T_{i+1}^{4}) g(r) + K_{i} (T_{i}) V_{i}^{2} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) V_{i}^{2} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}) V_{i}^{2} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4}) V_{i}^{2} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4}) V_{i}^{4} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4}) V_{i}^{4} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4}) V_{i}^{4} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4}) V_{i}^{4} T_{i} + K_{i} (T_{i}^{4}) G(r) + K_{i} (T_{i}^{4})$$

ことで、KTPは炉壁からの輻射を装わす項である。今、定常状態でのウェハ塩度に着目しウェハ間での温度変動を調べるため拡散項を省略する。

$$-2 T_{1}^{4} + a T_{F}^{4} = 0$$

$$-2 T_{1}^{4} + a (T_{-1}^{4} + T_{-1}^{4}) g(r) + K = 0$$

$$(i = 2, 3. ..., N)$$

$$-2 T_{N}^{4} + a T_{F}^{4} = 0$$
......(4)

$$T^{4}_{1-1} = \{ T(Z) - \frac{\partial T(Z)}{\partial Z} + \frac{1}{2} \frac{\partial^{2} T(Z)}{\partial Z^{2}} \dots \}^{4}$$

$$= T^{4} - 4 T^{3} \frac{\partial T}{\partial Z} + 2 T^{2} \frac{\partial^{2} T}{\partial Z^{2}} \dots (5)$$

$$\mathbf{T}^{4}\mathbf{I}_{+1} = \left\{ \mathbf{T} \left(\mathbf{Z} \right) + \frac{\partial \mathbf{T} \left(\mathbf{Z} \right)}{\partial \mathbf{Z}} + \frac{1}{2} \frac{\partial^{2} \mathbf{T} \left(\mathbf{Z} \right)}{\partial \mathbf{Z}^{2}} \dots \right\}^{4}$$

蟹温度TFを唯一の操作量として、炉蟹温度の両端部を中間部より高温にしてウェハ間の温度差を 機小にするような制御方法を取る事である。この アルゴリズムを実現するため次の評価関数を導入 する。

$$J = \int_{-\infty}^{L_B} (T(Z) - T^{\bullet})^2 dZ \rightarrow \min \quad \cdots \qquad (9)$$

CCでT ^{*}はウェハの段計臨度である。今、拡散炉 が対称な 3 ゾーン方式により**個度制御されている** としてT (2) は次のようになる。

$$T (Z) = \begin{cases} T_{0} : 0 \le Z \le \mathcal{L} \\ T_{L} : \mathcal{L} \le Z \le L_{0} - \mathcal{L} & \cdots (10) \\ T_{0} : L_{0} - \mathcal{L} \le Z \le L_{0} \end{cases}$$

(8)式, (10)式を(9)式に代入しTu, T k について それぞれJを変分し0と雌く事により次式を得る。

$$T_{\sigma} = \frac{\frac{2k}{k^{2}}(X+X')-(Y+Y')}{2(\frac{a}{2})^{\frac{1}{4}}(X+X')}$$

特開昭59-108119 (4)

$$= T^4 + 4 T^3 \frac{\partial T}{\partial Z} + 2 T^3 \frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} \quad \dots \qquad (6)$$

(5), (6)式を(4)式の第2式に代入してのに関して2回像分までとり、K'を温度依存性の非常に小さい定数として整理すると近似的に次式のようにむける。

$$\frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} = -\frac{1}{2} \frac{1 - ag}{ag} T = -K'TF \quad \cdots \qquad (7)$$

(4)式の第1,第3式の境界条件式を用いる事により(7)式の解は、

$$T(Z) = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^{\frac{1}{4}} T_{0} - \frac{K}{k^{2}}}{e^{k} L_{0} - e^{-k} L_{0}} ((1 - e^{-k} L_{0})) e^{k_{2}}$$
$$+ (e^{k} L_{0} - 1) e^{-k_{2}}) + \frac{K'}{k^{2}} T_{F} \cdots (8)$$

$$C C T k = \sqrt{\frac{1-a g}{a g}}$$

となる。(8)式によつて炭わされる2軸方向の虚歴 分布の大体の様子を第3図に示す。このように両 端部に近いりェハは中間部のウエハより低温とな る。しかるにりエハ間盤度均一化制御の方法は炉

ことで

$$X = \frac{A^{2}}{2 k} \left(2^{2kL} - 1 \right) + \frac{B^{2}}{2 h} \left(1 - e^{-2kL} \right) + 2ABL$$

$$X' = \frac{A^2}{2k} \left(e^{2kL_B} - e^{2k(L_B - L)} \right) + \frac{B^2}{2k} \left(e^{-2k(L_B - L)} - e^{-2kL_B} \right) + 2ABL$$

$$Y = (\frac{2 K'T_F}{k^3} - \frac{2 T}{k}) (\Lambda e^{kL} - B e^{-kL} - A + B)$$

$$Y' = \left(\frac{2\frac{K'T_F}{k^3} - \frac{2T}{k}\right) \left(Ae^{kL_8} - Be^{-kL_8}\right)$$

$$-Ae^{k(L_8 - 2)} + Be^{-k(L_8 - 2)}$$

$$\chi'' = \frac{\Lambda^2}{2k} \left(e^{2k(L_B - L)} - e^{2kL} \right) + \frac{B^2}{2k} \left(e^{-kL} \right)$$

$$Y'' = \left(\frac{2K'T_F}{k^B} - \frac{2T}{k}\right) \left(A e^{k(L_B - L)} + B e^{-k(L_B - L)}\right)$$
$$-A e^{kL} + B e^{-kL}$$

特開昭59-108119 (5)

さらに

$$A = \frac{1 - e^{-kL_B}}{e^{kL_B} - e^{-kL_B}} , B = \frac{e^{kL_B} - 1}{e^{kL_B} - e^{-kL_B}}$$

である。 Tェ 及びTu の大体の機子を第4図に示 す。(11)式によりウエハが均一加熱されるような 3 ゾーンの炉壁塩度が決定された訳であるが、と とで注意しなければならない事は炉漿温度を変え る事により(7)式の右辺は変化する事である。故に 再び(8)式に戻り(9)式の評価関数を最小化するよう 左To 及びTu を財算するというアルゴリズムを 終り返して最適な炉籃温度To ,TL を得る事 ができる。第5図は上記のアルゴリズムを示す。 第5図におけるそれぞれのステップでは次の処理 を行なう。

ステップ401:初期入力として、たとえば目標 の設計瘟度で、な験適計真装置 206に入力する。

ステップ102:(8)式によりウェハ間瘟度分布を 計算する。

ステップ 4 0 3 : (11) 式より対称 3 ゾーンの各々

2の実施例に示した方式によれば拡散炉内のウェ へを均一加熱するような炉壁温度の制御方式にお いて、熱方程式を遊に作成したモデルと評価関数 を用いて、該評価関数が最小となるように炉整温 度を操作するようにしたので最適な炉壁温度を決 定する事ができ、半導体特性のパラツキを低減し 歩留りを向上させる事が可能となる。これにより 高性能の半導体を安定に製造する事が可能になり その経済的効果は大きい。

図面の簡単な説明

第1図は本発明による拡散炉の第1の実施例の 構成図、第2図は本発明による拡散炉の第2の実 施例の構成図、第3図は炉鹽を均一加熱した際の ウエハ間温度分布を示し、第4図は3ゾーン方式 による炉漿協度分布を示し、第5図は制御のアル ゴリズムのフローチャートを示す。

101…拡散炉、102…ウェハ。

代理人 弁理士 賽田利幸 ጥジ



の温度Tu,TLを計算する。

ステップ404: T v , T L を用い再び(8)式によ り丁(乙)を計算する。

ステップ405:評価関数を競小化するTv,

T. かどうかを判定し、真(Y) ならTuをTo . TuをTu としTu とTL をヒータの覚 顔にセツトする。偽(N)左ら ステップ402亿戻りアルゴリ ズムを繰り返す。

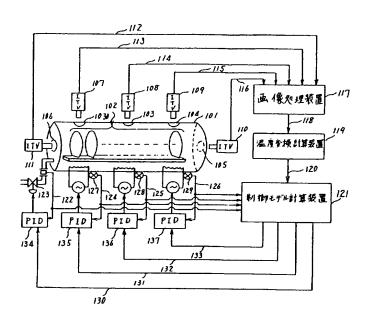
〔発明の効果〕

本発明によれば、炉内の被加熱物の外部温度が 画像処理技術により明らかとなり、更に、この温 度推定値を用いて、世加熱物の内部構度をモデル により推定することができ、この内部温度を目標 値に近づけるように、投入ガス硫量。ヒータ加熱 温度等の散定値を決めることができるから、これ まで勘とノウハウに頼つていた炉制御を、オンラ イン計測に基づく閉ループ制御とすることができ、 歩留り向上に大きな効果が期待できる。また、第

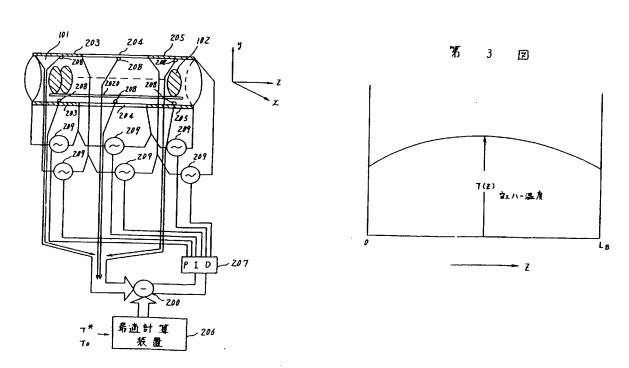
特開昭59-108119(6)

第1回

测制御方式



第 2 図



-124-

特開昭59-108119 (フ)

